



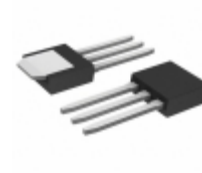





	GP1M003A050FG	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M003A050FG
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 2.5A TO220F
	Datenblätter:	 GP1M003A050FG.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 1994 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	GP1M003A050FG
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 2.5A TO220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1994 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	17.3W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 Ohm @ 1.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	395pF @ 25V
Verpackung	Tube

GP1M003A050FG ist neu im Original, Suche GP1M003A050FG Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie GP1M003A050FG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen. Anfrage GP1M003A050FG: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 GP1L57J KODENSHI GP1L57J KODENSHI	 GP1M003A080H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A TO220	 GP1M003A040PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 400V 2A IPAK	 GP1M003A080FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A TO220F
 GP1L57J0000F Sharp Microelectronics GP1L57J0000F SHARP	 GP1M003A050HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 2.5A TO220	 GP1M003A050CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 2.5A DPAK	 GP1M003A040CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 400V 2A DPAK

heiße Teile

Mehr

⊗ GP1A73AJ000F	↔ GP1A75EJ000F	⇒ GP1A75LBJ00F	D GP1FA501RZ	↔ GP1FA501TZ
⊣ GP1FA502RZ	⊗ GP1FA513TZ	D GP1FA51TKOF	⇒ GP1FA550RZ	↔ GP1FA550TZ
⊗ GP1FA551	⊣ GP1FA551TZ	⊗ GP1FA553RZ0F	↔ GP1FA553RZ0F	↔ GP1FA553TZ0F
D GP1FAV31TK0F	⊗ GP1FAV50RK0F	⊣ GP1FAV50TK0F	⊗ GP1FAV51TK0F	↔ GP1FD320TP0F
⇒ GP1FM313TMF5	↔ GP1FM313TZMF	⊗ GP1FSV51TK0F	⊣ GP1L53VJ000F	↔ GP1L57J0000F
↔ GP1M003A080CH	⇒ GP1M003A090C	D GP1M006A070FH	⊗ GP1M007A090H	⊣ GP1M008A025PG
⊗ GP1M009A020FG	D GP1M009A090N	⇒ GP1M010A060H	↔ GP1M010A080FH	↔ GP1M011A050FH
⊣ GP1M013A050H	⊗ GP1M016A025CG	↔ GP1M016A060F	⇒ GP1M016A060H	↔ GP1S092HCPI
⊗ GP1S092HCPIF	⊣ GP1S092HCPIF	⊗ GP1S092HCPKF	D GP1S093HCZ	↔ GP1S093HCZ0F
↔ GP1S093HCZ0F	⊗ GP1S093HCZ0F	⊣ GP1S094HCZ0F	⊗ GP1S094HCZ0F	↔ GP1S094HCZ0F

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited